

8吋後段化學清洗蝕刻工作站現有的標準製程

本機台現有之標準製程建立，是依廠務端中央化學品自動供應系統所提供之化學藥品進行調配為主。

1. 高溫槽：（提供H₂SO₄ 96% 、 H₂O₂ 31% 、 H₃PO₄ 86%等藥液）

薄膜材料	使用化學品	濃度	溫度	用途
金屬薄膜	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂	3:1	120°C	蝕刻
光阻	pure H ₂ SO ₄ +150c.c H ₂ O ₂	1:0	120°C	光阻去除
polymer	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂ : H ₂ O	8% : 4 % : 88%	45°C	去除polymer
W(鎢)	H ₂ O ₂	100%	60°C	去除W
SiN _x	H ₃ PO ₄ +150cc水	100%	150°C	氮化矽薄膜蝕刻
Si wafer	H ₂ O ₂	100%	75°C	沉積chemical oxide

2. PVDF循環槽：

薄膜材料	使用化學品	濃度	溫度	用途
二氧化矽薄膜	B. O. E 或 B. O. E + H ₂ O ₂	100% 或 不同比例	22±0.5 °C	後段SiO ₂ 蝕刻 或去除